

	<b>DMG3N60SJ3</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMG3N60SJ3
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMG3N60SJ3.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Enthält Blei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	DMG3N60SJ3
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 501V 650V TO251
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	41W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3, IPak, Short Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	354pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 2.8A (Tc) 41W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

DMG3N60SJ3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG3N60SJ3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG3N60SJ3 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG3N60SJ3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMG3443UVT-7</b> DIODES DMG3443UVT-7 DIODES</p>	 <p><b>DMG4406LSS</b> D DMG4406LSS D</p>	 <p><b>DMG4407SSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 9.9A 8-SO</p>	 <p><b>DMG3420U-7-F</b> D DMG3420U-7-F D</p>
 <p><b>DMG4406LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N CH 30V 10.3A 8-SO</p>	 <p><b>DMG3420U-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 5.47A SOT23</p>	 <p><b>DMG4413LSS</b> D DMG4413LSS D</p>	 <p><b>DMG3N60SCT</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 600V 3.3A TO220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG3N60SJ3 Diodes Incorporated	DMG3N60SJ3 Datenblatt	DMG3N60SJ3-Datenblätter	DMG3N60SJ3 PDF	Diodes Incorporated DMG3N60SJ3
DMG3N60SJ3 Electronic	DMG3N60SJ3-Komponenten	DMG3N60SJ3-Verteiler	DMG3N60SJ3-Bild	DMG3N60SJ3-Teil
DMG3N60SJ3 Preis	DMG3N60SJ3 Hersteller	DMG3N60SJ3 Bild	DMG3N60SJ3 Aktie	DMG3N60SJ3 Inventar
DMG3N60SJ3 Neu	DMG3N60SJ3 Original	DMG3N60SJ3 garantiert	DMG3N60SJ3 RFQ	DMG3N60SJ3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited